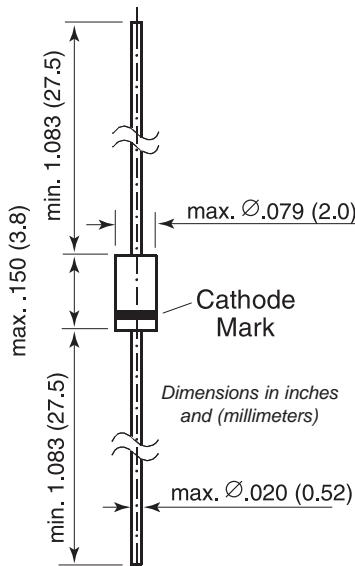


## Small-Signal Diode

 Reverse Voltage 100V  
 Forward Current 150mA

**DO-204AH (DO-35 Glass)**


### Features

- Silicon Epitaxial Planar Diode
- Fast switching diode

### Mechanical Data

**Case:** DO-35 Glass Case

**Weight:** approx. 0.13g

**Packaging Codes/Options:**

 F2/10K per Ammo tape (52mm), 50K/box  
 F3/10K per 13" reel (52mm tape), 50K/box

### Maximum Ratings and Thermal Characteristics

( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

Parameter	Symbol	Limit	Unit
Reverse voltage	$V_R$	75	V
Peak reverse voltage	$V_{RM}$	100	V
Maximum average rectified current half wave rectification with resistive load at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ and $f \geq 50\text{Hz}^{(1)}$	$I_{F(AV)}$	150	mA
Surge forward current at $t < 1\text{s}$ and $T_j = 25^\circ\text{C}$	$I_{FSM}$	500	mA
Maximum power dissipation at $T_{amb} = 25^\circ\text{C}^{(1)}$	$P_{tot}$	500	mW
Thermal resistance junction to ambient air $^{(1)}$	$R_{\theta JA}$	350	$^\circ\text{C/W}$
Maximum junction temperature	$T_J$	175	$^\circ\text{C}$
Storage temperature range	$T_S$	-65 to +175	$^\circ\text{C}$

### Electrical Characteristics

( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)

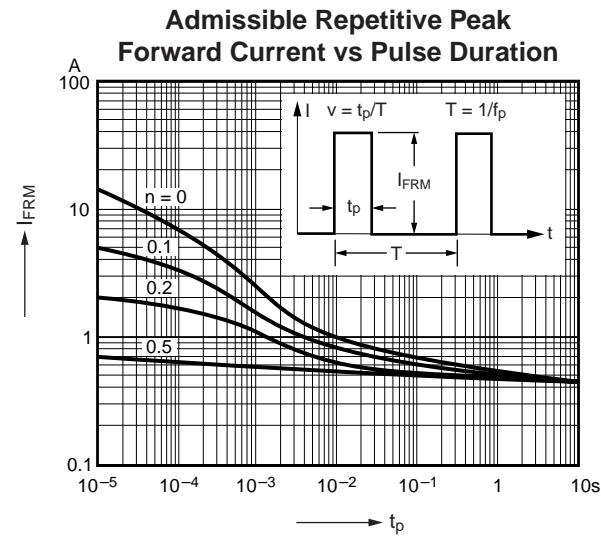
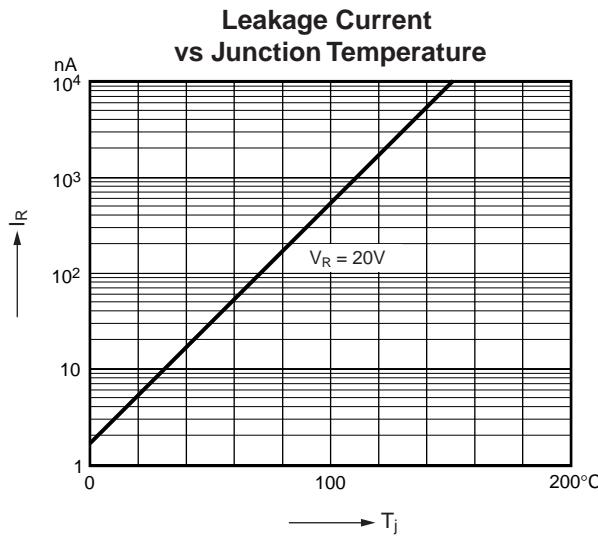
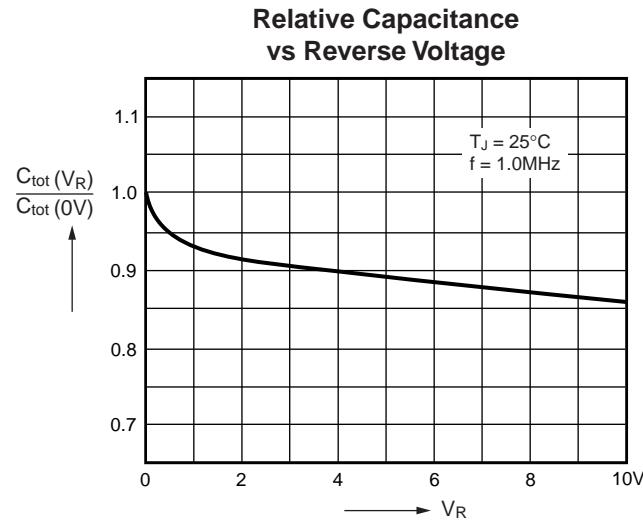
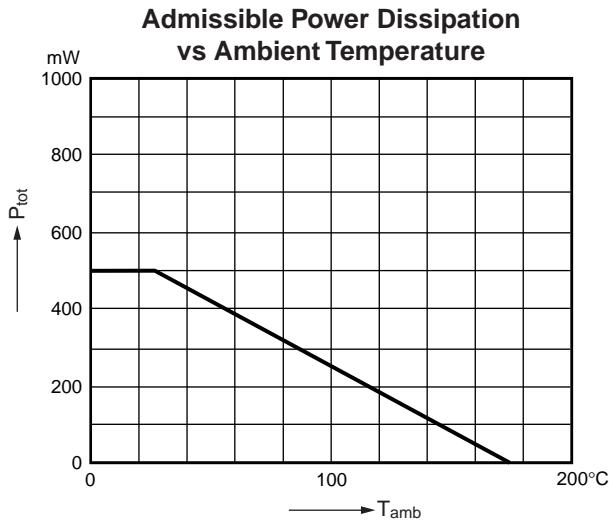
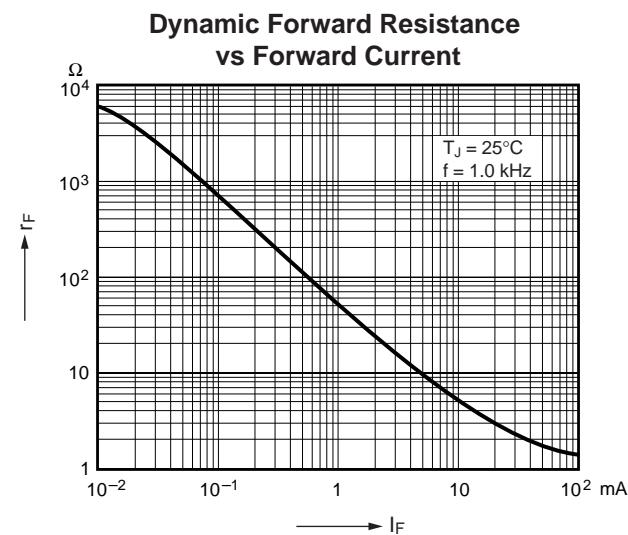
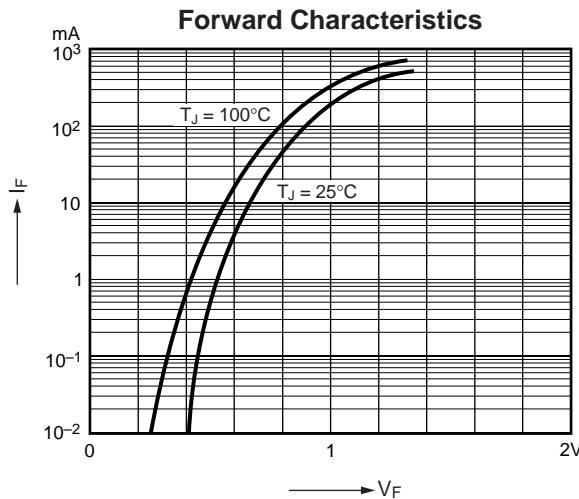
Parameter	Symbol	Min.	Max.	Unit
Maximum forward voltage drop at $I_F = 10\text{mA}$	$V_F$	-	1.0	V
Leakage current at $V_R = 50\text{V}$ at $V_R = 75\text{V}$	$I_R$	-	100 5	nA $\mu\text{A}$
Reverse breakdown voltage tested with $100\mu\text{A}$ pulses	$V_{(BR)R}$	100	-	V
Capacitance at $V_F = V_R = 0\text{V}$	$C_{tot}$	-	2	pF
Reverse recovery time from $I_F = 10\text{mA}$ to $I_R = 1\text{mA}$ , $V_R = 6\text{V}$ , $R_L = 100\Omega$	$t_{rr}$	-	4	ns
Rectification efficiency at $f = 100\text{MHz}$ , $V_{RF} = 2\text{V}$	$\eta_v$	0.45	-	-

**Note:**

(1) Valid provided that leads at a distance of 8mm from case are kept at ambient temperature

## Ratings and Characteristic Curves

( $T_A = 25^\circ\text{C}$  unless otherwise noted)



**Данный компонент на территории Российской Федерации****Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибуторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р В 0015-002 и ЭС РД 009

**Офис по работе с юридическими лицами:**

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru  
moschip.ru\_4

moschip.ru\_6  
moschip.ru\_9